

## 電子光科学 I

次の[I-1]から[I-7]の7問について、それぞれ別の解答用紙に答えよ。なお、各問題に2枚以上の解答用紙を用いる場合は、「[I-1]（2枚目）」などのように明記せよ。

[I-1]

下記の条件のもとで、実関数  $F(x, y, z) = xyz$  の極値を求めよ。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0, c > 0)$$

(配点 15 点)

[I-2]

複素数  $z = r \exp(i\theta)$  の正則関数を

$$f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$$

とする。  $u, v$  は実変数  $r, \theta$  の実数値関数であり、  $i$  は虚数単位である。以下の間に答えよ。ただし、  $r > 0$  とする。

(配点 20 点)

(1)  $\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{\partial u}{\partial \theta}, \frac{\partial v}{\partial r}, \frac{\partial v}{\partial \theta}$  が満たす Cauchy-Riemann の方程式を求めよ。

(2)  $z \frac{df}{dz}$  を  $\frac{\partial u}{\partial \theta}, \frac{\partial v}{\partial \theta}$  を用いて表せ。

(3)  $v(r, \theta) = p\theta$  とする。ここで、  $p$  は定数である。

a)  $u(r, \theta)$  を求めよ。

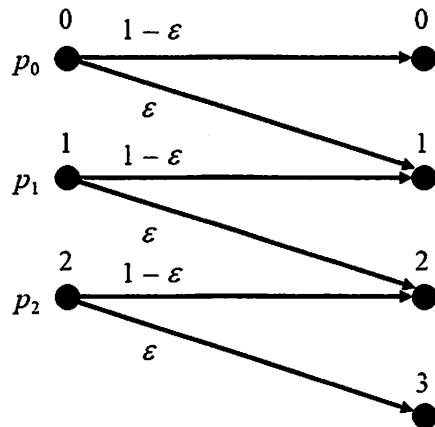
b)  $\int_C df$  を求めよ。ただし、  $C = \{z \mid |z| = 1\}$  である。

[I-3]

図に示すように、送信アルファベット $\{0, 1, 2\}$ の一つの符号が送信されると、受信アルファベット $\{0, 1, 2, 3\}$ の一つの符号が受信される通信路を考える。送信符号および受信符号を表す確率変数をそれぞれ $X$ および $Y$ とすると、 $Y=X$ となる確率は $1-\varepsilon$ 、 $Y=X+1$ となる確率は $\varepsilon$ である。また、 $X$ が $0, 1, 2$ となる確率をそれぞれ $p_0, p_1, p_2$ とし、 $p_0 + p_1 + p_2 = 1$ とする。以下の間に答えよ。なお、エントロピー、相互情報量、通信路容量の単位はビットとせよ。

(配点 20 点)

- (1)  $p_0 = p_1 = \frac{1}{2}$  における $X$ のエントロピー $H(X)$ を求めよ。
- (2) 問(1)の条件において、 $Y$ を条件とする $X$ の条件付きエントロピー $H(X|Y)$ を求めよ。
- (3) 問(1)の条件において、 $X$ と $Y$ の相互情報量 $I(X, Y)$ を求めよ。
- (4)  $p_0 = p_1 = \frac{1}{3}$  における $X$ と $Y$ の相互情報量 $I(X, Y)$ を求めよ。
- (5) 図の通信路において、 $\varepsilon = \frac{1}{2}$  とする。通信路容量が達成されるときの $p_0, p_1, p_2$ の関係で正しいものを以下から選び、(i)~(iii)の記号で答えよ。また、その理由も述べること。
  - (i)  $p_0 > p_2$ かつ $p_1 > p_2$
  - (ii)  $p_1 > p_0$ かつ $p_2 > p_0$
  - (iii)  $p_2 > p_1$ かつ $p_0 > p_1$
- (6)  $\varepsilon = \frac{1}{2}$  における図の通信路の通信路容量 $R$ を求めよ。



[I-4]

一次元量子系において、質量  $m$  の粒子が固有角振動数  $\omega$  で振動する調和振動子を考える。位置演算子  $\hat{x}$  および運動量演算子  $\hat{p}$  を、

$$\hat{x} = x, \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

として、ハミルトニアン  $\hat{H}$  は、

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

で与えられる。ただし、 $i$  は虚数単位、 $\hbar$  は換算プランク定数である。演算子  $\hat{A}, \hat{B}$  の交換関係を  $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$  とする。以下の間に答えよ。

(配点 20 点)

(1) 交換関係  $[\hat{x}, \hat{p}]$  を計算せよ。(2) 消滅演算子および生成演算子  $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$  を

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hat{p}, \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hat{p}$$

と定義する。交換関係  $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$  を求めよ。また、ハミルトニアン  $\hat{H}$  を  $\hat{a}, \hat{a}^\dagger, \hbar, \omega$  を用いて表せ。

(3) 演算子  $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$  の規格化された固有状態  $|n\rangle$  を  $\hat{n}|n\rangle = n|n\rangle$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ) と定義する。 $\hat{a}^\dagger|n\rangle$  を計算せよ。

(4) 状態  $|0\rangle$  の波動関数  $\psi_0(x)$  は、規格化因子  $C$ 、および  $r = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$  を用いて

$$\psi_0(x) = C \exp\left(-\frac{x^2}{2r^2}\right)$$

で与えられる。状態  $|1\rangle$  の波動関数  $\psi_1(x)$  を求めよ。ただし、 $C, r$  をそのまま用いて良い。

## [I-5]

原点を  $O$  とする直交座標系  $(x, y, z)$  における静電場について、以下の間に答えよ。ただし、真空の誘電率を  $\epsilon_0$  とする。

(配点 25 点)

- (1) 図 1 に示すように、誘電体 1 (誘電率  $\epsilon_1 > \epsilon_0$ ) に満たされた空間中の点  $(a, 0, 0)$  に電荷量  $Q_1$  の点電荷がある。このとき、 $y$  軸上の電場の  $x$  成分  $E_x$  と  $y$  成分  $E_y$  を求めよ。
- (2) 図 2 に示すように、誘電体 2 (誘電率  $\epsilon_2 > \epsilon_0$ ) に満たされた空間中の点  $(a, 0, 0)$  に電荷量  $Q_2$  の点電荷があり、また、点  $(-a, 0, 0)$  に電荷量  $Q_3$  の点電荷がある。このとき、 $y$  軸上の電場の  $x$  成分  $E_x$  と  $y$  成分  $E_y$  を求めよ。
- (3) 問(2)の状況において、 $x = \pm a$  を除いた  $x$  軸上の電束密度の  $x$  成分  $D_x$  を求めよ。
- (4) 図 3 に示すように、誘電体 1 と誘電体 2 が  $y-z$  面において接しており、点  $(a, 0, 0)$  に電荷量  $Q_2$  の点電荷がある。誘電体 1 中の電場の  $x$  成分を  $E_{1x}$ 、 $y$  成分を  $E_{1y}$  とする。また、誘電体 2 中の電場の  $x$  成分を  $E_{2x}$ 、 $y$  成分を  $E_{2y}$  とする。誘電体 1 と誘電体 2 の境界における  $E_{1x}$ 、 $E_{1y}$ 、 $E_{2x}$ 、 $E_{2y}$  の満たすべき条件を示せ。
- (5) 問(4)の状況において、 $y$  軸上の電場の  $y$  成分  $E_y$  を求めよ。

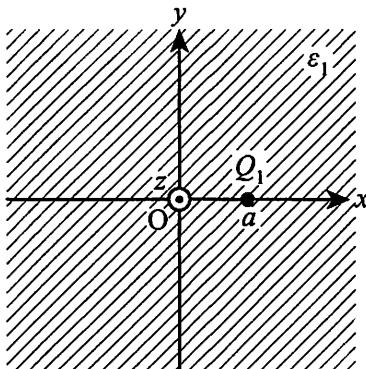


図 1

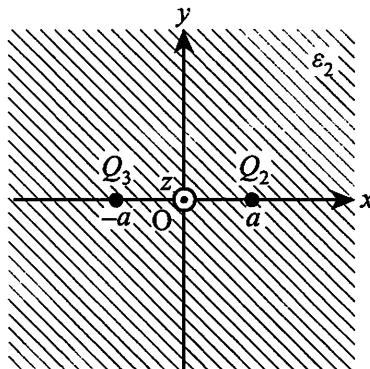


図 2

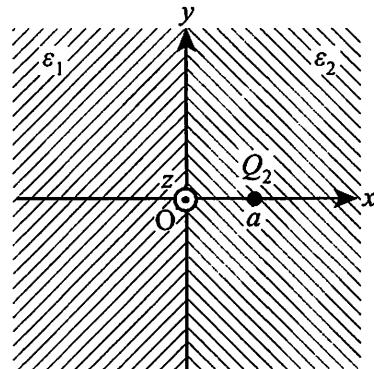


図 3

[I-6]

図1のように、真空中に半径がそれぞれ  $a_1$  および  $a_2$  の円形のコイル1およびコイル2が、中心軸を揃えて平行に置かれている。コイルの中心間の距離は  $d$  である。いま、コイル1に図の向きに強さ  $I$  ( $> 0$ ) の直流電流を流した。次の間に答えよ。ただし、 $d$  は  $a_1$  および  $a_2$  に比べて十分大きいものとする ( $d \gg a_1, a_2$ )。また、真空の透磁率を  $\mu_0$  とせよ。

(配点 25 点)

- (1) コイル1の中心における磁束密度の大きさを求めよ。
- (2) コイル2の中心における磁束密度の大きさを求めよ。
- (3) コイル1とコイル2の相互インダクタンスの絶対値を求めよ。

次に、図2のように2つのコイルを中心間の距離は変えずに回転し、同一平面内に置いた。そして、コイル1に図の向きに強さ  $I$  ( $> 0$ ) の直流電流を流した。

- (4) コイル2の中心における磁束密度の大きさを求めよ。
- (5) コイル1とコイル2の相互インダクタンスの絶対値を求めよ。

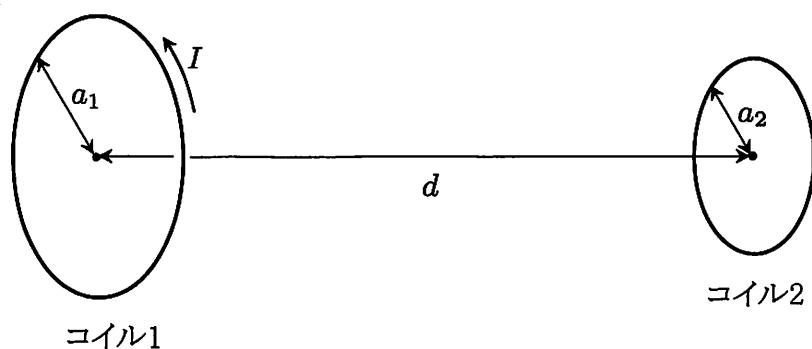


図1

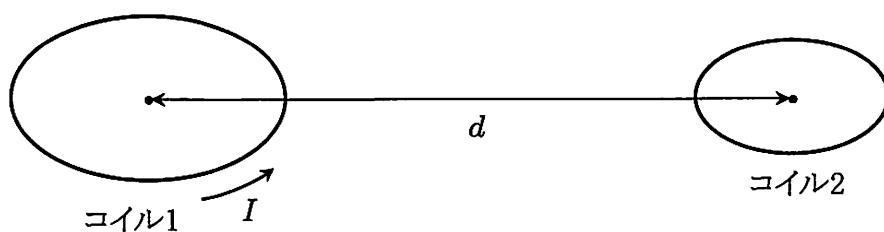


図2

[I-7]

図に示すように直交座標系  $(x, y, z)$ において、 $z = 0$  の位置で誘電体 1 (誘電率  $\epsilon_1 > 0$ , 透磁率  $\mu_1 > 0$ ) と誘電体 2 (誘電率  $\epsilon_2 > 0$ , 透磁率  $\mu_2 > 0$ ) が接している。その界面での電磁波の反射・透過現象を考える。入射波は平面波とする。電磁波の入射角, 反射角, 透過角は、図のように電磁波の進行方向と  $z$  軸のなす角で定義し、入射角と反射角は  $\theta_1$ , 透過角は  $\theta_2$  とする。ただし、 $0 \leq \theta_1 \leq \frac{\pi}{2}$  である。また、入射波, 反射波, 透過波の電場をそれぞれ  $\mathbf{E}_i = (E_{ix}, 0, 0)$ ,  $\mathbf{E}_r = (E_{rx}, 0, 0)$ ,  $\mathbf{E}_t = (E_{tx}, 0, 0)$ , 磁場をそれぞれ  $\mathbf{H}_i = (H_{ix}, H_{iy}, H_{iz})$ ,  $\mathbf{H}_r = (H_{rx}, H_{ry}, H_{rz})$ ,  $\mathbf{H}_t = (H_{tx}, H_{ty}, H_{tz})$  と表す。 $E_{ix}$ ,  $E_{rx}$ ,  $E_{tx}$  が下記のように表されるとき、以下の間に答えよ。なお、 $E_0$  は入射電場の振幅、 $A$  は反射電場の振幅、 $B$  は透過電場の振幅、 $\omega$  は電磁波の角周波数、 $k_1$ ,  $k_2$  はそれぞれの誘電体における電磁波の波数、 $t$  は時刻、 $j$  は虚数単位を表す。

$$\begin{aligned} E_{ix} &= E_0 \exp [-jk_1(z \cos \theta_1 + y \sin \theta_1)] \exp(j\omega t) \\ E_{rx} &= A \exp [-jk_1(-z \cos \theta_1 + y \sin \theta_1)] \exp(j\omega t) \\ E_{tx} &= B \exp [-jk_2(z \cos \theta_2 + y \sin \theta_2)] \exp(j\omega t) \end{aligned}$$

(配点 25 点)

- (1) 入射磁場  $\mathbf{H}_i$ , 反射磁場  $\mathbf{H}_r$ , 透過磁場  $\mathbf{H}_t$  の  $x$ ,  $y$ ,  $z$  軸方向の各成分を  $\epsilon_1$ ,  $\epsilon_2$ ,  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $E_{ix}$ ,  $E_{rx}$ ,  $E_{tx}$ ,  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  のうち必要なものを用いて表せ。
- (2) 誘電体 1 と誘電体 2 の誘電率の比を  $\epsilon_r = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$ , 透磁率の比を  $\mu_r = \frac{\mu_2}{\mu_1}$  とする。反射電場, 透過電場の振幅  $A$ ,  $B$  を、 $E_0$ ,  $\theta_1$ ,  $\theta_2$ ,  $\epsilon_r$ ,  $\mu_r$  のうち必要なものを用いて表せ。
- (3)  $\epsilon_1 \neq \epsilon_2$ ,  $\mu_r = 1$  としたとき、どのような角度で電磁波を入射しても、電場反射率  $\left(\frac{A}{E_0}\right)$  はゼロにはなりえないことを示せ。
- (4) いま、透磁率の比  $\mu_r$  が自由に与えられるとき、 $\epsilon_1 \neq \epsilon_2$  の条件で電場反射率がゼロとなる入射角  $\theta_1 = \theta_B$  が存在しうることを示せ。また、 $\mu_r$  を与えたとき、電場反射率がゼロとなる入射角  $\theta_B$  が存在するための  $\epsilon_r$  が取りうる範囲を  $\mu_r$  を用いて示せ。

